



ПОЛЮС БАС

**Установка осаждения
MR SEMI 2000 / 8000 PECVDS**

**Техническая
информация**

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 8000 PECVDS



Системы плазмохимического газофазного осаждения кластерного типа с одновременной обработкой 1 пластины. Доступны процессы субатмосферного осаждения (SA). Предназначены для серийных производств.

Стандартная конфигурация	MR SEMI 2000 PECVDS	MR SEMI 8000 PECVDS
Тип камеры	Загрузка 1 пластины	
Процессы	PECVD, SACVD	
Количество модулей	Процессный модуль-1 Охлаждение - 1	
Реакционный источник	Силан / TEOS	
Диаметр пластин	4", 6", 8"	
Платформа	четырёхугольная	восьмиугольная
Генератор плазмы	13,56 МГц, 2000Вт или 350 кГц, 900 Вт	
Нагрев пластины	Макс. температура 400°C (550°C для SA)	
SMIF	Доступен	

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbас.ru 🌐 www.polusbас.ru

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 8000 PECVDS

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 8000 PECVDS

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 8000 PECVDS